

NPN SILICON TRANSISTOR

# H13001

#### 主要用途

#### 高压快速开关

## 极限值(T<sub>a</sub>=25)

T <sub>stg</sub> ——贮存温度55~	150
T <sub>j</sub> ——结温	150
P <sub>C</sub> ——集电极耗散功率(Tc=25 )	10W
V <sub>CBO</sub> ——集电极—基极电压	600V
V <sub>CEO</sub> ——集电极—发射极电压	400V
V <sub>EBO</sub> ——发射极—基极电压	9V
Ic——集电极电流 ( DC )	0.25A

#### 外形图及引脚排列



- 1 基 极,B
- 2 集电极,C
- 3 发射极,E

#### 电参数(Ta=25)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单 位	测试条件	
BVceo	集电极—发射极击穿电压	400			V	I C=10mA, I B=0	
ВУсво	集电极—基极击穿电压	600			V	IC=1mA, IE=0	
ВVево	发射极—基极击穿电压	9			V	I = 1mA , $I = 0$	
I сво	集电极—基极截止电流			100	μΑ	Vcb=500V, I E=0	
I EBO	发射极—基极截止电流			100	μΑ	VEB=9V, I C=0	
HFE	直流电流增益	10		40		VcE=10V, Ic=20mA	
VCE (sat)	集电极—发射极饱和压降			0.6	V	Ic=100mA, IB=20mA	
VBE (sat)	基极—发射极饱和压降			1.2	V	Ic=100mA, IB=20mA	
fī	特征频率	8			MHz	VcE=10V , $Ic=20mA$	

## 分档及其标志

H1	H2	Н3	H4	H5
10-16	14-21	19-26	24-31	29-40